



**性能特点：**

- 频率范围： DC-20 GHz
- 增益： 11.8dB
- 噪声系数： 0.4dB
- 饱和电流： 51mA
- 关断电压： -0.85V
- 芯片尺寸： 0.278mm×0.288mm×0.1mm

**产品简介：**

XFET-7513 是一款超高电子迁移率晶体管（GaAs 场效应晶体管），高增益、低噪声指数，12GHz 噪声系数典型值为 0.4dB。适用于电信、卫星通信网络等低噪声场合应用。

**电参数：** (TA=25°C, Vd=+5V)

指标	条件	最小值	典型值	最大值	单位
饱和电流	Vds=2V, Vgs=0V	41	51	61	mA
跨导	Vds=2V, Ids=10mA	55	65	-	mS
关断电压	Vds=2V, Ids=1mA	-0.75	-0.85	-0.95	V
栅源击穿	Igs=-10uA	-3.0	-8.0	-	V
噪声系数	Vds=2V Ids=10mA@12GHz	-	0.4	0.65	dB
增益	Vds=2V Ids=10mA@12GHz	10	11.8	-	dB

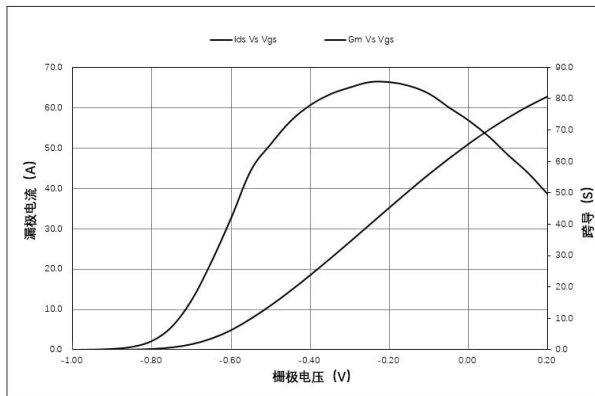
**使用极限参数：**

控制电压	+5V
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

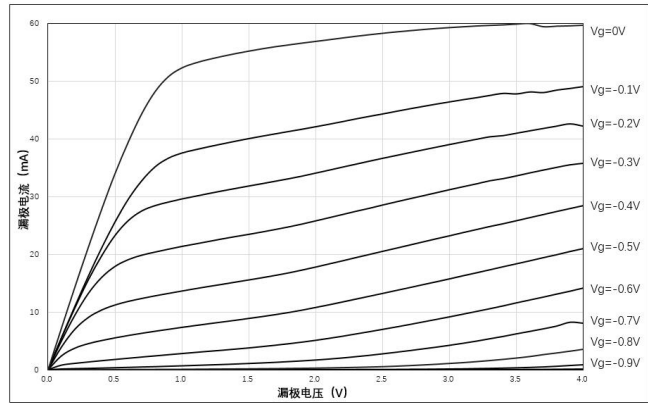


典型曲线：

漏极电流 & 跨导 Vs 栅极电压



漏极电流 Vs 漏极电压



使用注意事项：

- 1、在净化环境中使用，使用时不要碰触芯片表面。
- 2、干燥、氮气环境储存。